

Spezifikationen

Teilenummer	ALD110804PCL
Hersteller	Advanced Linear Devices, Inc.
Beschreibung	MOSFET 4N-CH 10.6V 16DIP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	420mV @ 1μA
Supplier Device-Gehäuse	16-PDIP
Serie	EPAD®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	500 Ohm @ 4.4V
Leistung - max	500mW
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	16-DIP (0.300", 7.62mm)
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2.5pF @ 5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Typ FET	4 N-Channel, Matched Pair
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	10.6V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	12mA, 3mA

Sie können auch interessiert

Verwandtes Hot-Keyword Mehr

Contact us: **Info@Y-IC.com**
HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited